

ГЕРМАНИЕВЫЕ МИКРОМОДУЛЬНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ ТМ-3А-3—ТМ-3Д-3 (*n-p-n*)

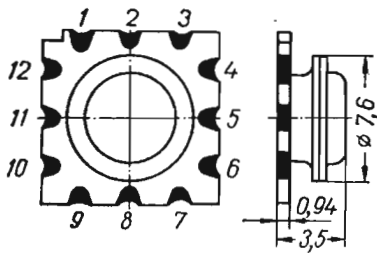


Рис. 233. Внешний вид и основные размеры микро-модульных транзисторов.

Конструктивное оформление — металлический герметизированный колпачок, устанавливаемый на микромодульной плате, с выводами, распаянными к пазам (см. рис. 233).

Вес 0,8 г.

Интервал рабочих температур от +73 до —60° С.

Допустимая относительная влажность окружающего воздуха 98% при температуре 40° С.

Интервал изменений атмосферного давления от 5 мм рт. ст. до 2 атм. Допускается применение транзисторов при атмосферном давлении до $1 \cdot 10^{-6}$ мм рт. ст.

Наибольшее линейное ускорение 150 g.

Наибольшее ускорение при многократных ударах 150 g.

Наибольшее допустимое ускорение при вибрациях с частотами 5—2000 гц 10 g.

Микротранзисторы монтируются на микромодульных платах размером $9,6 \times 9,6 \times 3,1$ мм и обозначаются буквами ТМ или М. Электроды транзисторов распаяются по пазам микромодульной платы: 1—база, 5—эмиттер, 8—коллектор.

Рабочее положение — любое.

Основное назначение — работа в аппарате различного назначения с микромодульным исполнением.

Параметры транзисторов приведены в табл. 121.

Таблица 121

Параметры	Тип транзистора				
	ТМ-3А-3	ТМ-3Б-3	ТМ-3В-3	ТМ-3Г-3	ТМ-3Д-3
Предельная частота усиления по току, Мгц	1	2	5	5	10
Коэффициент усиления по току в схеме с общим эмиттером	18—55	40—120	25—75	60—180	60—250
Наибольшее напряжение на коллекторе в схеме с общей базой, в	+15	+15	+15	+15	+15
Наибольшая рассеиваемая мощность, мвт	75	75	75	75	75